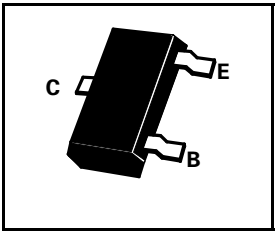
# SOT23 PNP SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS

# BCV26 BCV46

**ISSUE 3 – SEPTEMBER 1995**

FEATURES

* Low saturation voltage




COMPLEMENTARY TYPE – BCV26 - BCV27
BCV46 - BCV47

PARTMARKING DETAILS – BCV26 - ZFD
BCV46 - ZFE

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | BCV26 | BCV46 | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Collector-Base Voltage | $V_{CBO}$ | -40 | -80 | V |
| Collector-Emitter Voltage | $V_{CEO}$ | -30 | -60 | V |
| Emitter-Base Voltage | $V_{EBO}$ | -10 | | V |
| Peak Pulse Current | $I_{CM}$ | -800 | | mA |
| Continuous Collector Current | $I_C$ | -500 | | mA |
| Base Current | $I_B$ | -100 | | mA |
| Power Dissipation at $T_{amb}$=25°C | $P_{tot}$ | 330 | | mW |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j$:$T_{stg}$ | -55 to +150 | | °C |

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb}$ = 25°C unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | BCV26 | | BCV46 | | UNIT | CONDITIONS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | | |
| Collector-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)CBO}$ | -40 | | -80 | | V | $I_C$=100μA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $V_{(BR)CEO}$ | -30 | | -60 | | V | $I_C$=10mA * |
| Emitter-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)EBO}$ | -10 | | -10 | | V | $I_E$=10μA |
| Collector Cut-Off Current | $I_{CBO}$ | | -100<br>-10 | | -100<br>-10 | nA<br>nA<br>μA<br>μA | $V_{CB}$ = -30V<br>$V_{CB}$ = -60V<br>$V_{CB}$=-30V,$T_{amb}$=150°C<br>$V_{CB}$=-60V,$T_{amb}$=150°C |
| Emitter Base Cut-Off Current | $I_{EBO}$ | | -100 | | -100 | nA | $V_{EB}$=-4V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | | -1.0 | | -1.0 | V | $I_C$=-100mA,$I_B$=-0.1mA* |
| Base-Emitter Saturation Voltage | $V_{BE(sat)}$ | | -1.5 | | -1.5 | V | $I_C$=-100mA,$I_B$=-0.1mA* |
| Static Forward Current Transfer Ratio | $h_{FE}$ | 4K<br>10K<br>20K<br>4K | | 2K<br>4K<br>10K<br>2K | | | $I_C$=-100μA, $V_{CE}$=-1V†<br>$I_C$=-10mA, $V_{CE}$=-5V*<br>$I_C$=-100mA, $V_{CE}$=-5V*<br>$I_C$=-500mA, $V_{CE}$=-5V* |
| Transition Frequency | $f_T$ | 200 Typical | | 200 Typical | | MHz | $I_C$=-50mA, $V_{CE}$=-5V<br>f = 20MHz |
| Output Capacitance | $C_{obo}$ | 4.5 Typical | | 4.5 Typical | | pF | $V_{CB}$=-10V, f=1MHz |

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%
Spice parameter data is available upon request for these devices † Periodic Sample Test Only.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.